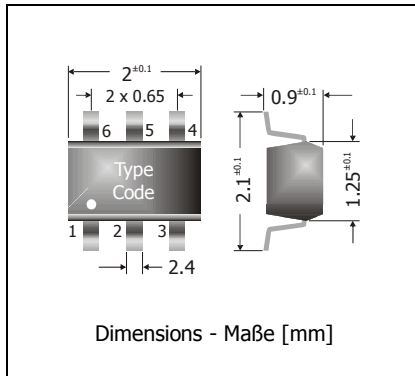


BAV70DW

Fast Switching Surface Mount Planar Diodes – Dual Common Cathode Schnelle Planar-Dioden für die Oberflächenmontage – Zweimal gemeinsame Kathode

Version 2015-05-28



Power dissipation – Verlustleistung	200 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	100 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse	SOT-363
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	



Maximum ratings (T_A = 25°C)

Grenzwerte (T_A = 25°C)

		MMBD4448SDW	
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	350 mW ¹⁾
Max. average forward current – Dauergrenzstrom (dc)		I _{FAV}	200 mA ¹⁾
Repetitive peak forward current – Periodischer Spitzenstrom		I _{FRM}	450 mA ¹⁾
Non repetitive peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	t _p ≤ 1 μs t _p ≤ 1 ms t _p ≤ 1 s	I _{FSM} I _{FSM} I _{FSM}	4 A 1 A 0.5 A
Repetitive peak reverse voltage – Periodische Spitzensperrspannung		V _{RRM}	100 V
Reverse voltage – Sperrspannung		V _R	100 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _j T _S	-55...+150°C -55...+150°C

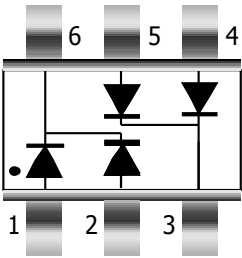
Characteristics (T_j = 25°C)

Kennwerte (T_j = 25°C)

Forward voltage ²⁾ Durchlass-Spannung ²⁾	I _F = 1 mA I _F = 10 mA I _F = 50 mA I _F = 150 mA	V _F V _F V _F V _F	< 715 mV < 855 mV < 1.0 V < 1.25 V
Leakage current Sperrstrom	T _j = 25°C V _R = 80 V V _R = 25 V	I _R I _R	< 500 nA < 30 nA
	T _j = 150°C V _R = 85 V V _R = 25 V	I _R I _R	< 100 μA < 30 μA
Max. junction capacitance – Max. Sperrschichtkapazität V _R = 0 V, f = 1 MHz		C _T	1.5 pF
Reverse recovery time – Sperrverzug I _F = 10 mA über/through I _R = 10 mA bis/to I _R = 1 mA		t _{rr}	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R _{thA}	< 625 K/W ¹⁾

1 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

2 Tested with pulses t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

Pinning – Anschlussbelegung		Marking – Stempelung
	<p>Fast Switching Diodes Schnelle Dioden</p> <p>1 = A1, 2 = A2, 3 = C3/C4 4 = A3, 5 = A4, 6 = C1/C2</p>	<p>BAV70DW = A4</p>

